Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U000270

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-01-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Нікітенко Євгеній Васильович
2. Nikitenko Yevheniy Vasilyevich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 16-01-2004

Спеціальність за освітою: 7.070201

Місце роботи здобувача: Чернігівський державний технологічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: 14027, м. Чернігів, Шевченка, 95

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К26.199.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки 41, 03028, м. Київ-28

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.13

Тема дисертації:

1. Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним потенціалом
2. The photoelastic effect in the cubic crystals with non-uniformity potential

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено виявленню фотопружного ефекту у напівпровідникових кристалах з неоднорідним розподілом потенціалу. За допомогою модуляції поляризації досліджено фотопружний ефект в кубічних кристалах при великих значеннях показника поглинання. Показано, що стан поляризації відбитого вздовж нормалі до поверхні кристалу світла пов'язаний з величиною анізотропії на довжині поглинання. У зразках кремнію, плавленого кварцу та поліметилметакрилату досліджено (в межах лінійної залежності від деформації різниці фаз між ортогональними компонентами поляризованої електромагнітної хвилі) ефект фотопружності, індукований градієнтом температури. В напівпровідниковому кристалі Ge із неоднорідністю концентрації N легуючої домішки у вигляді сходинки досліджено розподіл об'ємно-градієнтної фотоерс та двопроменезаломлення, зумовленого різницею головних компонентів механічної напруги. Виявлено якісне узгодження функції, отриманої інтегруванням просторової залежності величини анізотропії, та координатної залежностіфотоерс.

2. The dissertation is devoted to the detection of photoelastic effect in the semiconductor crystals with non-uniformity potential. With the help of modulation polarized was researched photoelastic effect in the cubic crystals by the great importance of the absorbs index. It was shown, that the condition of the polarized reflection along the normal to the surface of the crystals light involves anisotropy value on the length of absorb. Photoelastic effect which was induced by the temperature gradient was investigated in Si - , fused quarts and polymethylmethacrylate samples (the linear dependence of the waves phase on deformation) owing to optical polarization technique based on polarization modulation of irradiation. There were researched the distribution of the volume-gradient photo-E and double refraction, made conditional upon difference of the main components of the mechanical voltage in the transistorised crystal of Ge with the stepped non-uniformity of concentration N alloyed admixture. There was discovered qualitative agreed of the function, getting by integrate of the spaced dependence of the anisotropy value and co-ordinate dependence of the photo-E.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сердега Борис Кирилович
2. Serdega Boris Kirillovich

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вакуленко Олег Васильович

2. Вакуленко Олег Васильович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Григор'єв Микола Миколайович

2. Григор'єв Микола Миколайович

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Шейнкман Моісей Ківович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Шейнкман Моісей Ківович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.